

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載
 【部門区分】第6部門第2区分
 【発行日】平成17年4月7日(2005.4.7)

【公開番号】特開2003-280205(P2003-280205A)
 【公開日】平成15年10月2日(2003.10.2)
 【出願番号】特願2002-86459(P2002-86459)
 【国際特許分類第7版】

G 0 3 F 7/039
 C 0 8 F 210/14
 C 0 8 F 212/14
 C 0 8 F 220/10
 C 0 8 F 220/22
 C 0 8 F 232/00
 G 0 3 F 7/004
 H 0 1 L 21/027

【F I】

G 0 3 F 7/039 6 0 1
 C 0 8 F 210/14
 C 0 8 F 212/14
 C 0 8 F 220/10
 C 0 8 F 220/22
 C 0 8 F 232/00
 G 0 3 F 7/004 5 0 1
 H 0 1 L 21/30 5 0 2 R

【手続補正書】

【提出日】平成16年5月25日(2004.5.25)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

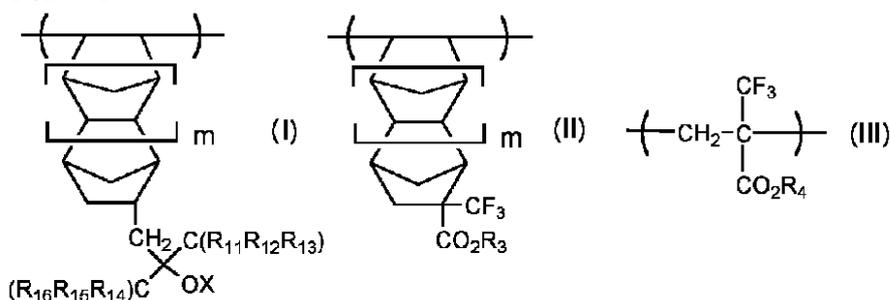
【補正の内容】

【特許請求の範囲】

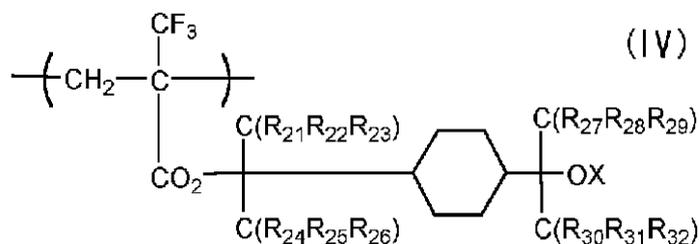
【請求項1】

- (A) 下記一般式(I)~(VI)で表される繰り返し単位から選ばれる少なくともひとつの繰り返し単位を有する、酸の作用により分解しアルカリ現像液に対する溶解度が増大する樹脂、
 (B) 活性光線又は放射線の照射により、酸を発生する化合物、
 (C) 溶剤、及び
 (D) 少なくともひとつのカルボキシル基を有する化合物
 を含有することを特徴とするポジ型レジスト組成物。

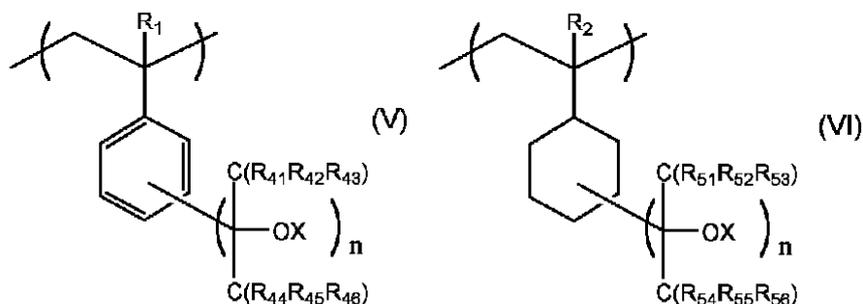
【化 1】



【化 2】



【化 3】



式 (I) 及び (II) において、 m は 0 又は 1 を表す。

式 (I) 及び (IV) ~ (VI) において、 X は、水素原子又は酸の作用により分解する基を表す。

式 (I) において、 $R_{11} \sim R_{16}$ は、各々独立に、水素原子、フッ素原子、又はフルオロアルキル基を表すが、少なくとも一つは水素原子ではない。

式 (II) において、 R_3 は、水素原子又は酸の作用により分解する基を表す。

式 (III) において、 R_4 は、水素原子又は酸の作用により分解する基を表す。

式 (IV) において、 $R_{21} \sim R_{32}$ は、各々独立に、水素原子、フッ素原子、又はフルオロアルキル基を表すが、少なくとも一つは水素原子ではない。

式 (V) 及び (VI) において、 R_1 及び R_2 は、水素原子、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、シアノ基、又はトリフルオロメチル基を表す。 $R_{41} \sim R_{46}$ 及び $R_{51} \sim R_{56}$ は、各々独立に、水素原子、フッ素原子、又はフルオロアルキル基を表すが、 $R_{41} \sim R_{46}$ のうちの少なくとも一つ及び $R_{51} \sim R_{56}$ のうちの少なくとも一つは水素原子ではない。 n は 1 ~ 5 の整数を表す。

【請求項 2】

請求項 1 に記載のポジ型レジスト組成物によりレジスト膜を形成し、当該レジスト膜を露光、現像することを特徴とするパターン形成方法。